

Önümçilik lazer arkaly döredilen plazma (LDP) usulyny ulanýar, bu tradision ASML tehnologiýasyndan tapawutlanýar. Täze çemeleşme enjamyň gurluşyny ýönekeýleşdirýär, energiýa netijeliligini ýokarlandyrýar we önümçilik çykdajylaryny azaltýar. Ilkinji maglumatlara görä, bu enjamlaryň köpçülikleýin önümçiligi 2026-njy ýylda başlap biler.

Hytaýyň uly çip öndürijisi SMIC henizem ýokary çykdajylar we pes önümçilik sebäpli 5-nanometrli ýarymgeçirijileriň köpçülikleýin önümçiliginde kynçylyk çekýär. Bu, şeýle hem, 7 nanometr geçmekde kynçylyk çekýän Huawei mümkinçiliklerini çäklendirýär. Hytaýda işlenip taýýarlanylýan täze enjam, ýurduň ýarymgeçirijiler senagatynyň ösmegini ep-esli derejede çaltlandyryjak öndebaryjy 13,5-nanometrli EUV-litografiýany ulanmagyna mümkinçilik berer.

Prototipleriň synaglary eýýäm Donguandaky Huawei barlag merkezinde geçirilýär. Sistemiň elektrodlaryň arasynda galynyň buharlandyryş usulyny ulanyp, soň bolsa ýokary naprýaženiýada plazmanyň ionlaşdyrylmagyny ulanyp işleýändigini barada habar berilýär. Bu proses, Ýewropa analoglary bilen deňeşdirilende, has elýeterli we energiýa tygşytlaýjy bolup, tehnologiýany köpçülikleýin ornaşdyrmak üçin perspektiwly edýär.